## JPA1976-150288 applied on June 7, 1976

Priority Netherland Patent 7506795 applied on June 9, 1975

## Inventor Johanes Santen at Philips

First Double junction Type Buried Photodiode with the resistive region, connecting the P surface to the high resistivity thick substrate wafer.

The RC delay time cannot be ignored.

This is not suited for high frequency Electric Shutter.

特	計 関(1)
特許庁長官	附和 5/ 年 6 月 <b>7</b> 日 片 山 石 郎 殿
1. 発明の名称	方式
10.2000	ソウか チ ソウチ 俗 ft
住 所 オラン	ダ国アインドーフエン エマシンゲル29
氏名 ヨハ	ネス・ヘリト・フアン・サンテン
3. 特許出願人	(ほか 1 名)
原 所 オランダ	「国アインドーフエン、エマシンゲル29
名 称 エヌ・ベ	ー・フィリップス・フルートを深シスアブリケン
代表者エル・	7- · ~1 N
国 締 オランダ	TE CONTRACTOR OF THE PROPERTY
4. 代 理 人	Z#####################################
	(京都千代田区優が関3丁目2番4号

府 (1)

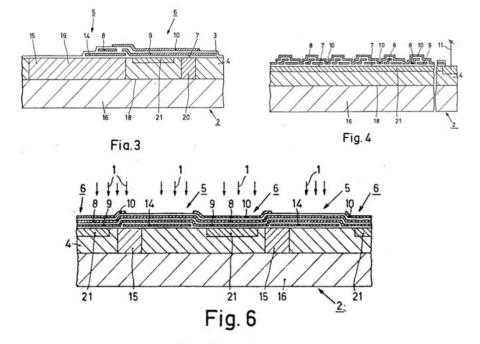
ıld:

00 m 🚱	優	1	无		格	ā	100000		主			張			0.000	PENCY
オラ	ンダ	[3]	19	75年	6	月	9	13	M	7	5	06	7	9	5	号
		国	19	年		月		B	N							号
		匪	19	辑		月		B	CAT.				3000 a 1	-		号

## 19 日本国特許庁

## 公開特許公報

①特開昭	51 - 150288
43公開日	昭51. (1976) 12. 23
21特願昭	51-65705
22出願日	昭5/. (1976) 6.7
審査請求	未請求 (全 <b>10</b> 頁)



Priority Netherland Patent 7506795 applied on June 9, 1975

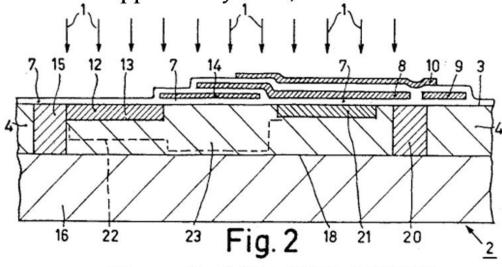


Figure 2 of JPA1976-150288